

5. Ben-Chorin M., Kux A. Adsorbate effects on photoluminescence and electrical conductivity of porous silicon, *Appl. Phys. Lett.*, 1994, no 64, pp. 481-483. DOI: 10.1063/1.111136

6. Galeazzo E., Peres H.E.M., Santos G. Gas sensitive porous silicon devices: Responses to organic vapors, *Sens. Actuat. B.*, 2003, no 93, pp. 384–390. DOI: 10.1016/S0925-4005(03)00200-4

7. Barillaro G., Diligenti A., Nannini A., Strambini L. Low-concentration NO<sub>2</sub> detection with an adsorption porous silicon FET, *IEEE Sensors. J.*, 2006, no 6, pp. 19-23. DOI: 10.1109/JSEN.2005.859360

8. Pavlenko N. N., Yatsunskyi I. R., Smyntyna V. A., Myndrul V. B., Kanevskaya O. S. [Applying of porous silicon obtained by metal-assisted chemical etching in sensors and microelectronics] *Proc. of the 14<sup>th</sup> International scientific-practical conference "Modern information and electronic technologies"*, 2013, pp. 214-216. (in Russian)

9. Smyntyna V., Iatsunskyi I., Sviridova O., Pavlenko N. Photoluminescence properties of nanostructured silicon fabricated by metal-assisted chemical etching, *Frontiers in*

*Optics Conference*, 2012, OSA Technical Digest (online), paper FTu1A.6.

10. Balasundaram K., Sadhu J.S., Shin J.C. Porosity control in metal-assisted chemical etching of degenerately doped silicon nanowires, *Nanotechnology*, 2012, vol. 23, no 30, pp. 305304-305311. DOI: 10.1088/0957-4484/23/30/305304

11. Harada Y., Li X., Bohn P.W., Nuzzo R.G. Catalytic amplification of the soft lithographic patterning of Si. Nonelectrochemical orthogonal fabrication of photoluminescent porous Si pixel arrays, *Journal of the American Chemical Society*, 2001, vol. 123, no 36, pp. 8709-8717.

12. Huang Z., Geyer N., Werner P. et al. Metal-assisted chemical etching of silicon: a review, *Mendeley*, 2011, no 23, pp. 285-308.

13. Iatsunskyi I.R., Smyntyna V.A., Pavlenko N.N. Ammonia detection using optical reflectance from porous silicon formed by metal-assisted chemical etching, *Proceedings of SPIE "Defense + Security"*, vol. 8901A, Germany, Dresden, 2013, paper 8901-20. DOI: 10.1117/12.2028497

## РЕЦЕНЗЕНТЫ НОМЕРА

*Белявский Евгений Данилович*, докт. физ.-мат. наук, профессор, НТУУ «Киевский политехнический институт»

*Болтовец Николай Силович*, канд. физ.-мат. наук, начальник отдела, НИИ «Орион», г. Киев

*Дружинин Анатолий Александрович*, докт. техн. наук, профессор, Национальный университет «Львовская политехника»

*Костылёв Виталий Петрович*, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

*Кудрик Ярослав Ярославович*, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАНУ, г. Киев

*Пелещак Роман Михайлович*, докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой, Дрогобычский государственный педагогический университет им. И.Франко

*Петлицкий Александр Николаевич*, канд. физ.-мат. наук, начальник лаборатории, Филиал НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ», г. Минск

*Пилипенко Владимир Александрович*, докт. техн. наук, заместитель директора, Филиал НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ», г. Минск

*Цона Александр Иванович*, докт. техн. наук, старший научный сотрудник, Харьковский национальный университет радиоэлектроники

*Шинкаренко Владимир Викторович*, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

*Dzvonkovskaya A.*, Dr. Sc., research scientist, Hamburg University of Technology

*Kabakchiev H.*, Dr. Habil, professor, Sofia University «St. Kliment Ohridski»

*Misiurewicz J.*, Dr. Sc., Warsaw University of Technology

*Pasternak M.*, professor, Military University of Technology, Warsaw

*Pietrasinski J.*, Ph. D., Head of Remote Sensing Division, Military University of Technology, Warsaw